

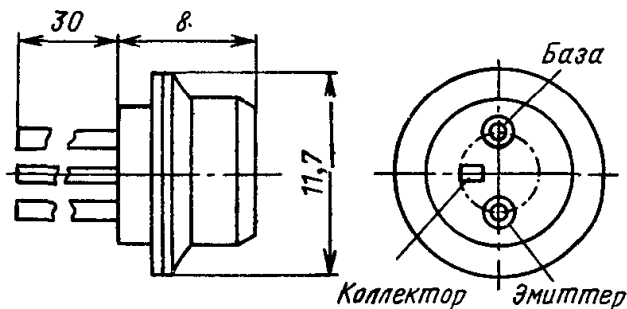
# 2Т608А, 2Т608Б, КТ608А, КТ608Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* переключа-  
тельные.

Предназначены для быстродействующих импульсных и высоко-  
частотных схем.

Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами.  
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 2 г.



## Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим  
эмиттером при  $U_{КБ} = 5$  В,  $I_Э = 200$  мА:

2Т608А:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| при $T = 298$ К . . . . . | .25 – 80  |
| при $T = 213$ К . . . . . | .10 – 80  |
| при $T = 398$ К . . . . . | .25 – 200 |

2Т608Б:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| при $T = 298$ К . . . . . | .50 – 160 |
| при $T = 213$ К . . . . . | .20 – 160 |
| при $T = 398$ К . . . . . | .50 – 300 |

КТ608А:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| при $T = 298$ К . . . . . | .20 – 80  |
| при $T = 228$ К . . . . . | .7 – 80   |
| при $T = 358$ К . . . . . | .20 – 200 |

КТ608Б:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| при $T = 298$ К . . . . . | .40 – 160 |
| при $T = 228$ К . . . . . | .15 – 160 |
| при $T = 358$ К . . . . . | .40 – 350 |

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)

Энергоатомиздат, 1985

|   |        |
|---|--------|
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 400$ мА,        |        |
| $I_B = 80$ мА не более . . . . .                                  | 1 В    |
| типовое значение . . . . .  | 0,4* В |
| Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 400$ мА, $I_B =$     |        |
| $= 80$ мА не более . . . . .                                      | 2 В    |
| типовое значение . . . . .  | 1* В   |
| Время рассасывания при $I_K = 150$ мА, $I_{B1} = I_{B2} = 15$ мА  |        |
| 2Т608А, 2Т608Б не более . . . . .                                 | 100 нс |
| типовое значение . . . . .  | 45* нс |
| КТ608А, КТ608Б не более . . . . .                                 | 120 нс |
| Модуль коэффициента передачи тока при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_K =$    |        |
| $= 30$ мА, $f = 100$ МГц не менее . . . . .                       | 2      |
| типовое значение . . . . .  | 4,5*   |
| Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ0} = 10$ В не бо-        |        |
| лее . . . . .   | 15 пФ  |
| типовое значение . . . . .  | 8* пФ  |
| Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ0} = 0$ не более . . . . . |        |
| 50 пФ   |        |
| Обратный ток коллектора, не более                                 |        |
| при $T = 298$ К, $U_{КБ} = 60$ В . . . . .                        | 10 мкА |
| при $T = 398$ К, $U_{КБ} = 45$ В 2Т608А, 2Т608Б . . . . .         | 80 мкА |
| Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ0} = 4$ В не более . . . . .      |        |
| 10 мкА  |        |

**Предельные эксплуатационные данные**

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при

$R_{ЭБ} \leq 1$  кОм:

2Т608А, 2Т608Б:

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| при $T_n = 213 \div 373$ К . . . . . | 60 В |
| при $T_n = 398$ К . . . . .          | 45 В |
| при $T_n = 423$ К . . . . .          | 30 В |

КТ608А, КТ608Б:

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| при $T_n = 228 \div 343$ К . . . . . | 60 В |
| при $T_n = 393$ К . . . . .          | 30 В |

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при

$R_{ЭБ} \leq 1$  кОм,  $\tau_n \leq 10$  мкс,  $Q \geq 2$ ;

2Т608А, 2Т608Б

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| при $T_n = 213 \div 373$ К . . . . . | 80 В |
| при $T_n = 398$ К . . . . .          | 65 В |
| при $T_n = 423$ К . . . . .          | 40 В |

КТ608А, КТ608Б:

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| при $T_n = 228 \div 343$ К . . . . . | 80 В |
| при $T_n = 393$ К . . . . .          | 40 В |

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)

Энергоатомиздат, 1985

Постоянное напряжение коллектор-база:

2Т608А, 2Т608Б:

при  $T_n = 213 \div 373$  К . . . . . 60 В

при  $T_n = 398$  К . . . . . 45 В

при  $T_n = 423$  К . . . . . 30 В

КТ608А, КТ608Б:

при  $T_n = 228 \div 343$  К . . . . . 60 В

при  $T_n = 393$  К . . . . . 30 В

Импульсное напряжение коллектор-база при  $\tau_n \leq 10$  мкс,

$Q > 2$ :

2Т608А, 2Т608Б:

при  $T_n = 213 \div 373$  К . . . . . 80 В

при  $T_n = 398$  К . . . . . 65 В

при  $T_n = 423$  К . . . . . 40 В

КТ608А, КТ608Б:

при  $T_n = 228 \div 343$  К . . . . . 80 В

при  $T_n = 393$  К . . . . . 40 В

Постоянное напряжение эмиттер-база . . . . . 4 В

Импульсное напряжение эмиттер-база при  $\tau_n \leq 10$  мкс,

$Q \geq 2$  . . . . . 8 В

Постоянный ток коллектора . . . . . 400 мА

Импульсный ток коллектора при  $\tau_n \leq 10$  мкс,  $Q \geq 2$  800 мА

Импульсный обратный ток эмиттера при  $\tau_n \leq 10$  мкс,

$Q \geq 2$  . . . . . 2 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

2Т608А, 2Т608Б:

при  $T = 213 \div 323$  К . . . . . 0,5 Вт

при  $T = 398$  К . . . . . 0,12 Вт

КТ608А, КТ608Б:

при  $T = 228 \div 298$  К . . . . . 0,5 Вт

при  $T = 358$  К . . . . . 0,12 Вт

Тепловое сопротивление переход-среда . . . . . 200 К/Вт

Температура перехода:

2Т608А, 2Т608Б . . . . . 423 К

КТ608А, КТ608Б . . . . . 393 К

Температура окружающей среды:

2Т608А, 2Т608Б . . . . . 213 – 398 К

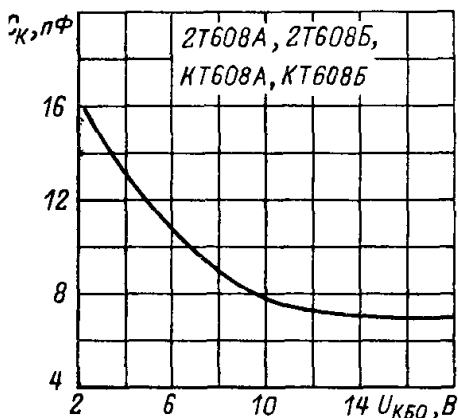
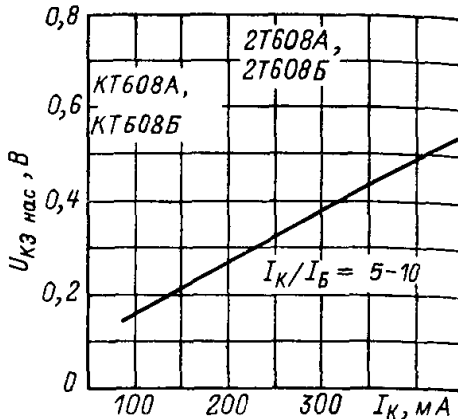
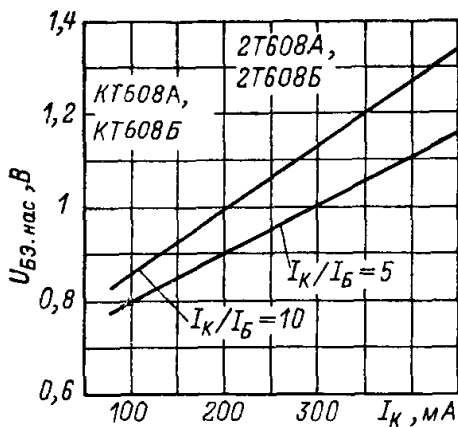
КТ608А, КТ608Б . . . . . 228 – 358 К

Примечание. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзисторов при температуре пайки не более 533 К в течение 10 с. Допускается изгиб выводов на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора с радиусом изгиба 1,5–2 мм. Значение допустимого электростатического потенциала не более 1000 В.

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)

Энергоатомиздат, 1985



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.

Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.

Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база.

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)  
Энергоатомиздат, 1985

